

تحسين كفاءة الخلية الشمسية بالتشعيع النيوتروني والتلدين الحراري

سبحي سعيد الرواوى * راجحة رشيد القره غولي ** وسن علي الطائي ***

تاریخ قبول النشر ٢٠٠٦/١٠/٣

الخلاصة :

يهدف هذا البحث الى دراسة تأثير كل من النيوترونات بطاقة تتراوح ما بين 4-8 Mev والتلدين الحراري على كفاءة الخلايا الشمسية لمادة السليكون الاحادي البلوره حيث تمت دراسة الخصائص الكهربائية I-V (I-V) لهذه الخلايا في حالتي الظلام والاضاءة قبل وبعد التشعيع وباستخدام المصدر المصدر النيوتروني (Be-²⁴¹Am). كذلك تمت دراسة الخصائص الكهربائية (I-V) للخلايا الشمسية قبل وبعد التلدين . كانت اعلى زيادة وصلت اليها الكفاءة بعد التشعيع بالنيوترونات السريعة هي 3.81% اما اعلى زيادة في الكفاءة بعد التلدين فكانت 0.72% .

المقدمة :

يتزايد الاهتمام بالطاقة الشمسية يوماً بعد اخر كونها تمثل البديل الامثل للتغطية التقchan في مصادر الطاقة التقليدية ، حيث تتركز البحوث على كيفية استغلال الطاقة الشمسية لتصنيع المزدوجات الحرارية والمجمعات والخلايا الشمسية لتحويل الطاقة الشمسية الى طاقة حرارية او كهربائية .

تم تصنيع اول خلية شمسية عام 1954 م من قبل Chapin وجماعته وبكفاءة تحويل تقارب 6% بعدها جرت محاولات عديدة لتحسين كفاءة الخلية للوصول الى كفاءة تقارب 19% [1].

النظريّة:

من المعروف ان للطاقة اشكال متعددة على ان اكثر ما يهمنا من اشكال الطاقة في مجال الطاقة الشمسية ، هي الطاقة الاشعاعية والتي يتم تحويلها الى طاقة كهربائية عن طريق :

- 1 - التحويل المباشر : وتم بواسطة الخلايا الشمسية (القولطاضوئية).
- 2 - التحويل غير المباشر : كطريقة التحويل الايوني الحراري .

3 - الطريقة الكهروحرارية [2]

عند سقوط اشعة ضوئية ذات طول موجي مناسب على شبه موصل فان هناك ثلاثة حالات لتفاعل هذه الاشعة مع هذا الشبه الموصل يمكن ان تحدث:

اذا كانت طاقة الفوتونات الساقطة اقل من طاقة الفجوة فان هذه الاشعة سوف لن تتمكن بسبب عدم قدرة هذه الطاقة على نقل الالكترون الى مستوى اعلى من مستوى الطاقة المعنوية وبهذا فإنها اما تتعكس عن السطح او تتفاوت الحالة الاخرى . اما اذا كانت طاقة

* جامعة تكريت/ كلية العلوم / قسم الفيزياء

** جامعة بغداد/ كلية العلوم للبنات / قسم الفيزياء

*** جامعة النهرين/ كلية العلوم / قسم الفيزياء

حراريا من خلال عملية التلدين (Annealing) التي تجري غالبا بوجود غاز معين او في الهواء او في الفراغ وفق الحاجة . هذه المعاملة الحرارية تساعد على التقليل من العيوب التركيبية حيث تعطي طاقة حرارية لذرات المادة وبهذا ستحاول ان تعيد ترتيبها وتأخذ مكانها ضمن الترتيب الدوري ولكنها في نفس الوقت تتسبب في تكوين او ازالة مستويات موضعية داخل فجوة الطاقة وهذا يؤدي الى تقليل او زيادة مقاومة الغشاء [11] .

كفاءة الخلية الشمسية :

وتمثل النسبة بين القدرة الكهربائية المترددة التي قدرة الضوء الساقط عند نقطة القدرة العظمى لمنحني (التيار - فولتية). انظر شكل (1)

القدرة العظمى P_{max} تعطى بالعلاقة التالية :

$$P_{max} = I_m V_m \quad (1)$$

حيث V_m ، I_m يمثلان تيار وفولتية العمل عند نقطة القدرة العظمى ، فإذا كانت P_{in} هي قدرة الاشعة الساقطة على الخلية فان كفاءة الخلية الشمسية (٦) تعطى بالعلاقة الآتية [12]

$$\eta = (P_{max} / P_{in}) \times 100\%$$

$$\eta = (I_m V_m / P_{in}) \times 100\%$$

الجزء العملي :

١- التشيع

شعّعت نماذج من الخلايا الشمسية الجاهزة المصنوعة من شركة المنصور بالنيوترونات السريعة المنبعثة من المصدر النيوتروني $Am-241$ ذات فيض (Flux) مقداره $7.9 \times 10^5 n/cm^2$ وفترات زمنية مختلفة و كما موضح في الجدولين (1) ، (2) .

٢- التلدين

تم تلدين الخلايا الشمسية باستخدام الفرن الحراري نوع (Carbolite) في الفراغ وتحت ضغط 10^{-3} mbar

ولمدة (30 min) كما موضح في الجدولين (3) ،

(4) كما تم تلدين خلية (S_3) المشععة بعد وصولها إلى حالة الاستقرار ولمدة (30 min) انظر الجدولين (5) ، (6) .

تم قياس الخصائص الكهربائية (I-V) في الحالتين عند الإضاءة والظلام وكذلك قبل وبعد التشيع والتلدين باستخدام مصدر ضوئي ، مصباح هالوجين نوع (Phillips) ذات قدرة (120 watt) موضوع على مسافة ثابتة عن الخلية .

١ - تفاعلات الاستطرارة :- وتنقسم إلى استطرارة مرنة وغير مرنة . عند تشيع نموذج ما بنيوترونات سريعة تتراوح طاقتها ما بين Mev (0.5-20) فإن التفاعل الممكن حدوثه هو الاستطرارة بنوعيها المرنة وغير المرنة .

فعدما تكون الطاقة الحركية للنيوترون والنواء محفوظة قبل وبعد التصادم ، فإن الاستطرارة سوف تكون من النوع المرن ذلك أن سقوط النيوترون على المادة واصطدامه بالنواة سيؤدي إلى استطرارته بطاقة حرارية أقل من طاقته الأصلية لهذا يبقى مجموع الطاقة الحركية محفوظا ذلك أن الطاقة المفقودة سوف تذهب إلى نواة الهدف وتحول إلى طاقة حرارية للنواة المرتدة بعد التصادم . تعطى طاقة النيوترون بعد التصادم (2)

بالعلاقة التالية : [6]

$$E_2 = E_1 (A^2 + 2ACos \Theta + 1) ^{1/2}$$

حيث E_2 : طاقة النيوترون بعد التصادم ، E_1 : طاقة النيوترون قبل التصادم ، A : كتلة النواة .

اما عندما تكون الطاقة الحركية للنيوترون الساقط ونواة الهدف غير محفظتان قبل وبعد التصادم ، فإن الاستطرارة تكون غير مرنة ، يحدث هذا عندما يكون للنيوترون الساقط طاقة كافية بحيث تستطيع ان ترفع نواة الهدف الى مستوى الاشارة الاول (على الاقل) لنعود النواة بعدها الى حالة الاستقرار ببعضها اشعة كما . طاقة النيوترون المستطرار تعطى بالعلاقة التالية [8,7]

$$E_n = E_n - E_1$$

٢ - تفاعلات الامتصاص:- وتنقسم إلى الانشطار النيوتروني والتشيط النيوتروني

يحدث الانشطار النيوتروني عندما تتصادم النواة النيوترونات ذات الطاقة العالية ، تكون بذلك نواة مركبة غير مستقرة تتشرط بعدها الى نواتين متقاربتين في الكتلة مع ابعاد نيوترونين او ثلاثة واشعة كما يعود السبب في ذلك الى وجود مستويات طاقية للنواة متقاربة ومتعددة حيث يتألف كل نواة الرجوع الى وضع استقرارها حسب ما اكتسبته من طاقة [9] .

اما التشيط النيوتروني فيحدث عند قصف النواة او امتصاصها لنيوترون ذات طاقة مناسبة، مما يسبب في تنشيطها بان يرفع مستوى طاقتها من المستوى الارضي الى مستويات متهدجة أعلى اعتمادا على طاقة النيوترون وطبيعة مادة الهدف [10] .

لا بد من الاشارة الى انه يمكن ازالة الاجهادات المترددة في المادة من خلال اعادة ترتيب الانحلالات او احداث انتشار لشوائب لزيادة الفاعلية الكهربائية لها . يمكن معاملة المادة

(1.05%) جدول (5). وهذا يعني ان التلدين قد استعاد جزءا من النقصان الذي حصل في كل من P_{max} ، V_{oc} ، I_{sc} ، η ، بعد ان انخفضت تدريجيا نتيجة التشيع حتى الوصول الى حالة الاستقرار ، انظر الاشكال (13) و(14).

لابد لنا ان نذكر ان خطة البحث الاساسية كانت تشتمل على تشيع النماذج لجرعات مختلفة اخرى الا ان حدوث عطل في منظومة التشيع دام لفترة طويلة حال دون ذلك . كذلك لابد لنا من القول الى ان تشيع النماذج لم يكن تراكميا اي ان كل نموذج تم تشعيته على انفراد ولمدة المذكورة ازاءه في الجدول (1) ، ذلك لأن النتائج السابقة (التراكيمية) بينت ان الزيادة في الكفاءة كانت اقل مما لو تم التشيع لنفس الفترة وبصورة مستمرة.

ثانيا : خصائص (I-V) في حالة الظلام

1- التشيع
الشكلين (3) ، (4) يوضحان خصائص (I-V) في حالة الظلام لجميع النماذج قبل وبعد التشيع ، حيث يلاحظ انخفاض تيار الاشباع I_0 مع انخفاض عامل المثالية n لجميع الخلايا (S1) ، (S2) ، (S3) ، (S4) ، (S5) بعد التشيع المباشر .

حيث لوحظ من خلال تشيع خلية S3 ان الانخفاض في قيمة I_0 مساوي الى (0.557mA) والانخفاض في قيمة n مساوي الى (1.96) .

2- التلدين
يوضح الشكلين (9) ، (10) خصائص (I-V) الظلامية للخلايا الشمسية المستخدمة قبل وبعد التلدين ، حيث لوحظ ارتفاع قيمة I_0 مع ارتفاع قيمة n بعد التلدين المباشر للخلايا Sa و Sb ، حيث حصل انخفاض في قيمتي I_0 و n لخلايا Sa و Sb . بالنسبة للخلية Sc فللحظ ان الانخفاض في I_0 و n مساوي الى (0.095mA) (0.85) على التوالي كما موضح في الجدول (4) .

3- التشيع والتلدين
الشكل (15) يوضح خصائص (I-V) الظلامية ل الخلية S3 المشعة ثم لدنت بعد استقرارها فتم الحصول على انخفاض في قيمة I_0 بمقدار (0.005mA) وانخفاض في قيمة n بمقدار (0.02) . انظر الجدول (6) .

النتائج :

اولا : خصائص (I-V) في حالة الاضاءة

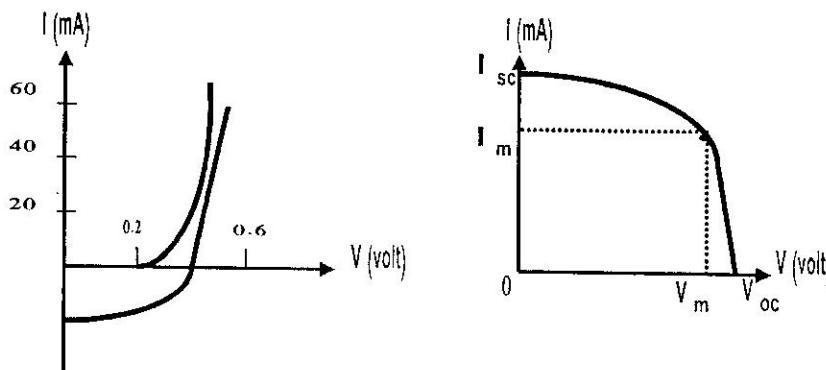
1- التشيع
الاشكال (1) و (2) و (5) و (6) تمثل خصائص (I-V) قبل وبعد التشيع لجميع النماذج مع عدم استخدام واستخدام مجهر القدرة على التوالي ولفترات زمنية مختلفة وجرعة اشعاعية واحدة . يلاحظ وجود زيادة في قيمة تيار الدائرة القصيرة I_{sc} لكافة الحالات وكذلك زيادة في فولتبة الدائرة المفتوحة V_{oc} لخلايا S1 ، S5 ، S3 ، S2 ، S4 . بهذا ازدادت القدرة العضلى P_{max} لكافة النماذج وبالتالي زيادة في الكفاءة η كما موضح في الجدول (1) .

لقد تم الحصول من خلال اختبار النموذج (S3) المشع لفترة (15min) على زيادة في I_{sc} وهي أعلى زيادة تم الحصول عليها من التشيع أما الزيادة في V_{oc} فكانت متساوية إلى (0.01 v) وهذا ادى الى زيادة الكفاءة بنسبة (3.81%) .

2- التلدين
من معالجنة المنحنيات في الشكلين (7) و(8) بدون استخدام مجهر القدرة والشكلين (11) و (12) باستخدامه حيث تمثل هذه المنحنيات خصائص (I-V) قبل التلدين وبعده ولجميع النماذج ،

نلاحظ وجود انخفاض في I_{sc} للنموذجين Sa و Sb مع بقاء قيمة V_{oc} ثابتة للكليهما وهذا ادى الى انخفاض في القدرة العظمى وبالتالي انخفاض في كفاءة الخلية . اما النموذجين Sc و Sd فقد لوحظ زيادة التيار I_{sc} لهمما زادت V_{oc} ثابتة ل الخلية Sc مع بقاء قيمة V_{oc} ثابتة ل الخلية Sd وهذا ادى الى زيادة الكفاءة للنموذجين كما موضح في الجدول (3) .
لقد تم الحصول من خلال النموذج Sc الملون لفترة (30min) وبدرجة حرارة (300 °C) على زيادة في I_{sc} كانت بمقدار (4.5mA) وزيادة في V_{oc} قدرها (0.03v) وهذا ادى الى زيادة في الكفاءة بنسبة 0.72% وهي تمثل أعلى زيادة تم الحصول عليها .

3- التشيع والتلدين
اجري تلدين للخلية S3 المشعة لمدة (15min) بعد استقرارها بدرجة حرارة (300 °C) فللحظ حدوث زيادة في I_{sc} بمقدار (9.5mA) و بمقدار (0.01v) وبذلك زادت الكفاءة بنسبة



(الشكل ١)

(ا) يمثل منحني (I-V) للخلية عند الاضاءة
والاضاءة وباستخدام مجهر القدرة .
بدون استخدام مجهر القدرة .

جدول (١) : يبين خصائص (I-V) في حالة الاضاءة قبل وبعد التشعيغ

	Cell.NO	t(min)	Isc (mA)	V _{oc} (v)	P _{max} (watt)	الزيادة المئوية في %
قبل التشعيغ	S1	5	33.7	0.46	0.01169	8.5
بعد التشعيغ	S1	5	49.8	0.48	0.01221	8.88
قبل التشعيغ	S2	10	38.2	0.46	0.006118	4.453
بعد التشعيغ	S2	10	39.6	0.45	0.00865	6.29
قبل التشعيغ	S3	15	31.4	0.44	0.004086	2.97
بعد التشعيغ	S3	15	43.1	0.45	0.009315	6.78
قبل التشعيغ	S4	20	28	0.44	0.00472	3.43
بعد التشعيغ	S4	20	37.3	0.44	0.006854	4.98
قبل التشعيغ	S5	25	43	0.29	0.007	5
بعد التشعيغ	S5	25	47.3	0.3	0.00754	5.48

جدول (٢) : يبين خصائص (I-V) في حالة الظلام قبل وبعد التشعيغ

	CelL. NO	t (min)	I _o (mA)	n
قبل التشعيغ	S1	5	0.14	1.87
بعد التشعيغ	S1	5	0.12	1.85
قبل التشعيغ	S2	10	0.25	1.55
بعد التشعيغ	S2	10	0.12	1.35
قبل التشعيغ	S3	15	0.6	3.09
بعد التشعيغ	S3	15	0.043	1.13
قبل التشعيغ	S4	20	0.19	2.53
بعد التشعيغ	S4	20	0.14	2.16
قبل التشعيغ	S5	25	0.019	1.36
بعد التشعيغ	S5	25	0.012	1.22

جدول (٣) : يبين خصائص (I-V) في حالة الاضاءة قبل وبعد التشعيغ

	Cell.NO	T(°C)	Isc (mA)	V _{oc} (v)	P _{max} (watt)	الزيادة المئوية في %
قبل التلدين	Sa	100	34	0.48	0.009936	7.23
بعد التلدين	Sa	100	33.4	0.48	0.00816	5.93
قبل التلدين	Sb	200	34.8	0.48	0.01018	7.41
بعد التلدين	Sb	200	34	0.48	0.009454	6.88
قبل التلدين	Sc	300	27.3	0.44	0.007161	5.21
بعد التلدين	Sc	300	31.8	0.47	0.00816	5.93
قبل التلدين	Sd	400	34.9	0.5	0.010656	7.75
بعد التلدين	Sd	400	36.6	0.5	0.011124	8.09

1.05%) جدول (5). وهذا يعني ان التدرين قد استعاد جزءا من النقصان الذي حصل في كل من I_{sc} ، V_{oc} ، P_{max} بعد ان انخفضت تدريجيا نتيجة التشيع حتى الوصول الى حالة الاستقرار ، انظر الاشكال (13) و (14).

لابد لنا ان نذكر ان خطة البحث الاساسية كانت تشمل على تشيع النماذج لجرعات مختلفة اخرى الا ان حدوث عطل في منظومة التشيع دام لفترة طويلة حال دون ذلك . كذلك لابد لنا من القول الى ان تشيع النماذج لم يكن تراكميا اي ان كل نموذج تم تشيعه على انفراد وللمدة المذكورة ازاءه في الجدول (1) ، ذلك لأن النتائج السابقة (التراكمية) بينت ان الزيادة في الكفاءة كانت اقل مما لو تم التشيع لنفس الفترة وبصورة مستمرة.

ثانيا : خصائص (I-V) في حالة الظلام

1- التشيع
الشكلين (3) ، (4) يوضحان خصائص (I-V) في حالة الظلام لجميع النماذج قبل وبعد التشيع ، حيث يلاحظ انخفاض تيار الاشباع I_0 مع انخفاض عامل المثالى n لجميع الخلايا (S1) ، (S2) ، (S3) ، (S4) ، (S5) بعد التشيع المباشر .

حيث لوحظ من خلال تشيع خلية S3 ان الانخفاض في قيمة I_0 مساوي الى (0.557mA) والانخفاض في قيمة n مساوي الى (1.96) .

2- التدرين
يوضح الشكلين (9) ، (10) خصائص (I-V) الظلامية للخلايا الشمسية المستخدمة قبل وبعد التدرين ، حيث لوحظ ارتفاع قيمة I_0 مع ارتفاع قيمة n بعد التدرين المباشر للخلايا Sb ، Sa و Sc . بالنسبة للخلية Sc فلوحظ ان الانخفاض في I_0 و n مساوي الى (0.095mA) (0.85) على التوالي كما موضح في الجدول (4) .

3- التشيع والتدرين
الشكل (15) يوضح خصائص (I-V) الظلامية ل الخلية S3 المشعة ثم لدنت بعد استقرارها فتم الحصول على انخفاض في قيمة I_0 بمقدار (0.005mA) وانخفاض في قيمة n بمقدار (0.02) انظر الجدول (6) .

النتائج :

اولا : خصائص (I-V) في حالة الاضاءة

1- التشيع
الاشكال (1) و (2) و (5) و (6) تمثل خصائص (I-V) قبل وبعد التشيع لجميع النماذج مع عدم استخدام واستخدام مجهر القدرة على التوالي ولفترات زمنية مختلفة وبجرعة اشعاعية واحدة . يلاحظ وجود زيادة في قيمة تيار الدائرة القصيرة I_{sc} لكافة الحالات وكذلك زيادة في فولتبة الدائرة المفتوحة V_{oc} للخلايا S1 ، S3 ، S5 ولكن مع حصول نقصان طفيف في هذا الجهد ل الخلية S2 وبقاءه ثابتا ل الخلية S4 . بهذا ازدادت القدرة العضمي P_{max} لكافة النماذج وبالتالي زيادة في الكفاءة η كما موضح في الجدول (1) .

لقد تم الحصول من خلال اختبار النموذج (S3) المشع ولفترة (15min) على زيادة في I_{sc} وهي اعلى زيادة تم الحصول عليها من التشيع اما الزيادة في V_{oc} فكانت متساوية الى (0.01 v) وهذا ادى الى زيادة الكفاءة بنسبة (3.81%) .

2- التدرين
من معالينة المنحنيات في الشكلين (7) و (8) بدون استخدام مجهر القدرة والشكلين (11) و (12) باستخدامه حيث تمثل هذه المنحنيات خصائص (I-V) قبل التدرين وبعده ولجميع النماذج ،

يلاحظ وجود انخفاض في I_{sc} للنموذجين Sa و Sb مع بقاء قيمة V_{oc} ثابتة لكليهما وهذا ادى الى انخفاض في القدرة العظمى P_{max} وبالتالي انخفاض في كفاءة الخلية . اما النموذجين Sc و Sd فقد لوحظ زيادة التيار I_{sc} لهما كما زادت V_{oc} ل الخلية Sc مع بقاء قيمة V_{oc} ثابتة ل الخلية Sd وهذا ادى الى زيادة الكفاءة للنموذجين كما موضح في الجدول (3) .
لقد تم الحصول من خلال النموذج Sc المطعن لفترة (30min) وبدرجة حرارة (300 °C) وزيادة على زيادة في I_{sc} كانت بمقدار (4.5mA) في V_{oc} قدرها (0.03v) وهذا ادى الى زيادة في الكفاءة بنسبة 0.72% وهي تمثل اعلى زيادة تم الحصول عليها .

3- التشيع والتدرين
اجري تدرين للخلية S3 المشعة لمدة (15min) بعد استقرارها بدرجة حرارة (300 °C) فللحظ حدوث زيادة في I_{sc} بمقدار (9.5mA) و V_{oc} بمقدار (0.01v) وبذلك زادت الكفاءة بنسبة

جدول (٤) : يبين خصائص (I-V) في حالة الظلام قبل وبعد التلدين

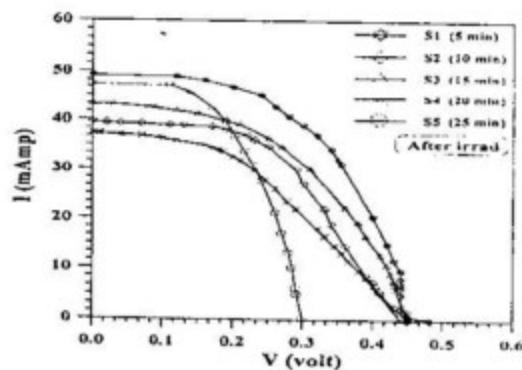
	Cell. NO	T(°C)	I _o (mA)	n
قبل التلدين	Sa	100	0.045	1.65
بعد التلدين			0.07	2.03
قبل التلدين	Sb	200	0.16	1.52
بعد التلدين			0.25	2.43
قبل التلدين	Sc	300	0.14	2.41
بعد التلدين			0.045	1.56
قبل التلدين	Sd	400	0.034	1.32
بعد التلدين			0.032	1.31

جدول (٥) : يبين خصائص (I-V) في حالة الأضاءة لخلية S3 بعد وصولها إلى حالة الاستقرار ثم تلدينهما

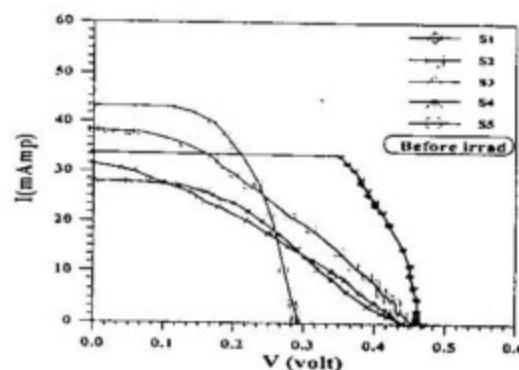
	Cell.NO	t(min)	T(°C)	I _{sc} (mA)	V _{oc} (v)	P _{max} (watt)	الزيادة المئوية في I _{sc}
بعد الاستقرار	S3	15	300	29.1	0.45	0.00494	3.59
بعد التلدين				38.6	0.46	0.006375	4.64

جدول (٦) : يبين خصائص (I-V) في حالة الظلام لخلية S3 بعد وصولها إلى حالة الاستقرار ثم تلدينهما

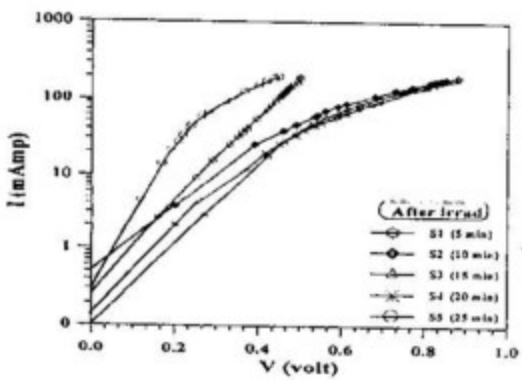
	Cell. NO	t(min)	T(°C)	I _o (mA)	n
بعد الاستقرار	S3	15	300	0.05	1.11
بعد التلدين				0.045	1.09



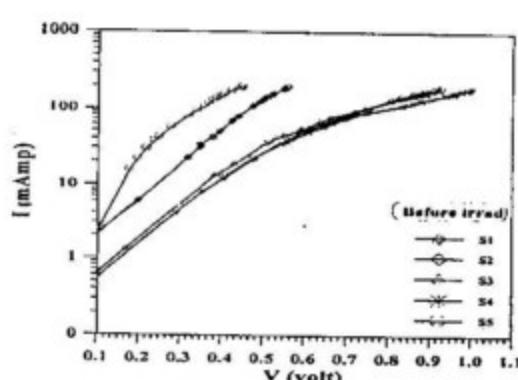
شكل (٢): خصائص (I-V) في حالة الأضاءة بعد التلدين بدون بعمر القدرة .



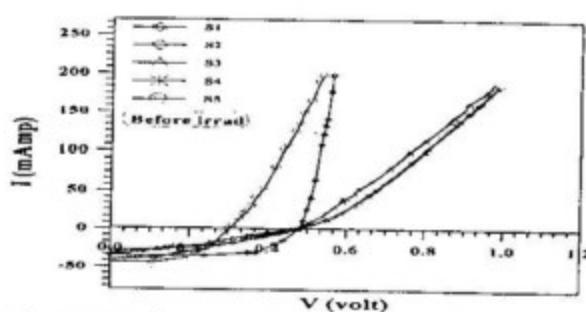
شكل (١): خصائص (I-V) في حالة الأضاءة قبل التلدين بدون بعمر القدرة .



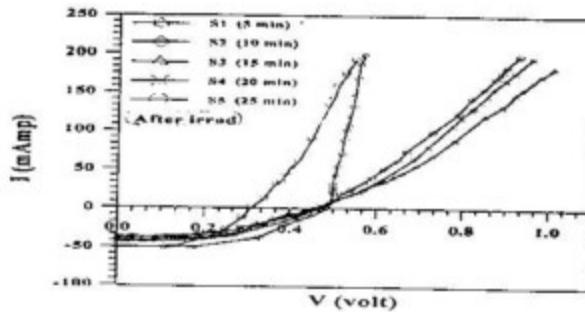
شكل (٤) : خصائص (I-V) في حالة العسلام بعد التلدين باستخدام بعمر القدرة .



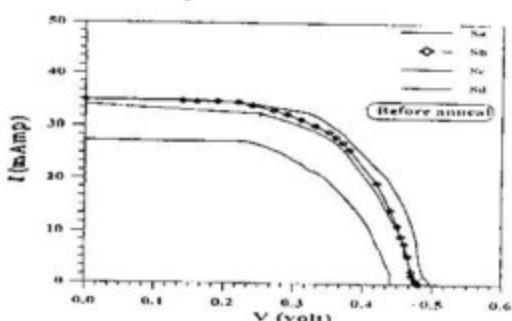
شكل (٣) : خصائص (I-V) في حالة العسلام قبل التلدين باستخدام بعمر القدرة .



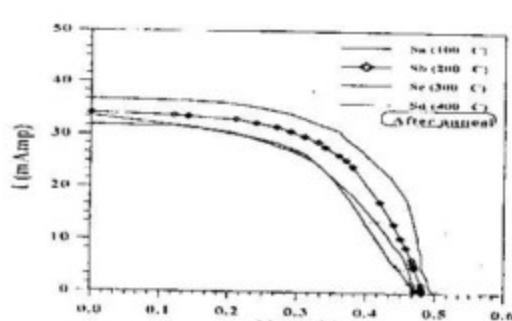
شكل (٥): عصائص (I-V) في حالة الأطاء قبل التشعيع باستخدام مجهر القدرة



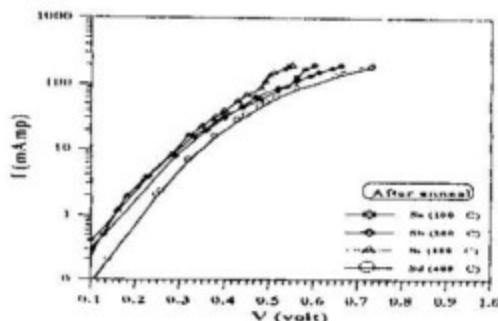
شكل (٦): عصائص (I-V) في حالة الأطاء بعد التشعيع باستخدام مجهر القدرة .



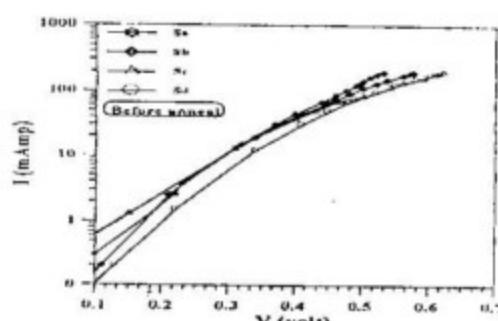
شكل (٧): عصائص (I-V) في حالة الأطاء
قبل التلدين بدون مجهر القدرة .



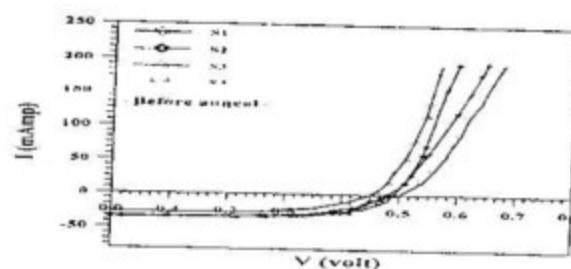
شكل (٨): عصائص (I-V) في حالة الأطاء
بعد التلدين بدون مجهر القدرة .



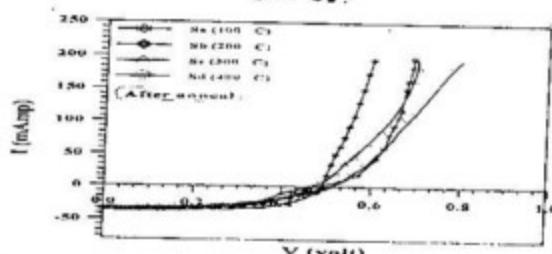
شكل (٩): عصائص (I-V) في حالة الصلاجم
بعد التلدين باستخدام مجهر القدرة .



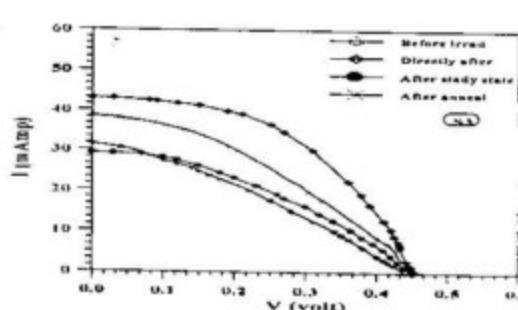
شكل (١٠): عصائص (I-V) في حالة الصلاجم
قبل التلدين باستخدام مجهر القدرة .



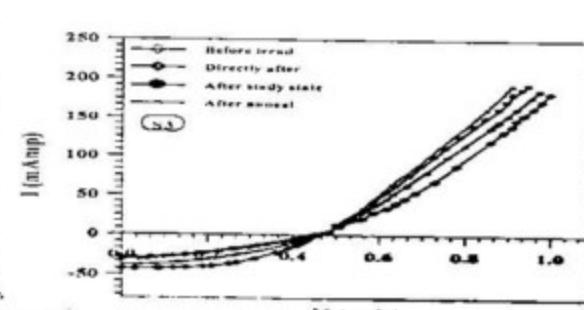
شكل (١١): عصائص (س-I-V) في حالة الأختناعة قبل التلدين باستخدام بمهر القدرة



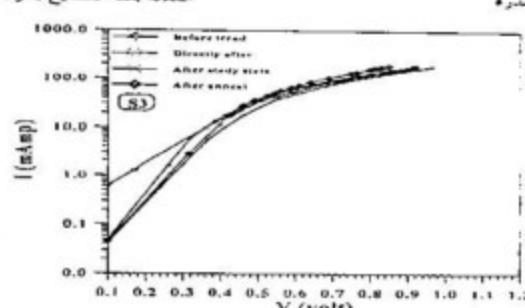
شكل (١٢): عصائص (س-I-V) في حالة الأختناعة بعد التلدين باستخدام بمهر القدرة .



شكل (١٣): عصائص (س-I-V) في حالة الأختناعة خلية (S3) قبل التلدين
المقدمة بعد المتصفح بدون بمهر القدرة .



شكل (١٤): عصائص (س-I-V) في حالة الأختناعة خلية (S3) : التلدين
بعد المتصفح باستخدام بمهر القدرة .



شكل (١٥): عصائص (س-I-V) في حالة الطلام خلية (S3) التلدين بعد المتصفح باستخدام بمهر القدرة .

$$V_{oc} = KT/e \ln(1+I_L/I_0)$$

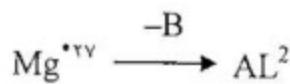
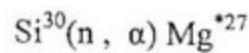
حيث يمثل : - I_L : التيار المتردض ضوئيا ، e : شحنة الالكترون اما بالنسبة الى النتائين في الفراغ فانه يعمل على طرد الاوكسجين الموجود في المادة وهذا ادى الى انخفاض كل من كثافة الالكترونات والجهد الحاجز واطلاق سراح الالكترونات المصطادة مماقاد الى زيادة في كل من تركيز هذه الالكترونات والتحريكية والتوصيلية وبالتالي زيادة الكفاءة [16] من جانب اخر فان المعاملة الحرارية تمكن الالكترون المتردح حراريا في الخلايا من اكتساب طاقة حرارية بفعل المجال الكهربائي المسلط بدرجة كافية تسمح له عند الاصطدام بذرة ان يكسر اصارة الشبكة ويولد زوجا من الالكترون - فجوة . هذا الزوج المتردح سوف يكتسب طاقة حرارية من المجال الكهربائي وبدوره يتمكن من توليد زوج جديد من الالكترون - فجوة وهكذا تستمرة هذه العملية لتوليد ازواج اخرى وتدعى هذه العملية بالتضاعف التيهوري (Avalanch) وبزيادة درجة الحرارة يزداد عدد الالكترونات المنتجة حراريا [17] وبذلك يزداد عرض منطقة الاستنزاف وطول انتشار الحاملات الاقلية مما يؤدي الى زيادة في تيار الدائرة القصيرة وفولتية الدائرة المفتوحة نتيجة زيادة توليد حاملات الشحنة في منطقة الاستنزاف . يؤدي طول الانتشار العالى الى التقليل من معدل اعادة الاتحاد [18] مما يزيد من عامل الملى وبالتالي انخفاض في مقاومة التوالى .

وهذا يفسر سبب الاستعادة لخصائص الخلية المشعة S3 بعد معاملتها حراريا حيث زاد زمن البقاء وطول الانتشار للحاملات وكفاءة التجسيم نتيجة انحلال العيوب المؤقتة وابادة لازواج فرنكل وشوتكي الحادثة [19]. اما سبب الانخفاض للنماذج المذكورة تحت درجات حرارية واطنة فيعود الى ان درجة الحرارة غير كافية لاحادث الطرد الكافي لذرات الاوكسجين من المادة وهذا سبب اختلاف وعدم انتظام في ترتيب الذرات داخل الشبكة البلورية مما ادى الى انخفاض الكفاءة .

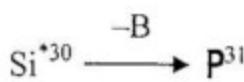
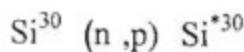
ثانيا : خصائص (I-V) في حالة الظلام استخدمت معلم الخلية I_0 ولتفسير ميكانيكية انتقال التيار في الخلية . فعندما يكون المفرق مثالي اي ان قيمة $n=1$ يهيمن تيار الانتشار (عند مستويات التيار العالية) في حين تصبح $n=2$ عندما يكون التيار ناشئ عن اعادة الاتحاد في

المناقشة :

اولا: خصائص (I-V) في حالة الاضاءة ان الزيادة الحاصلة في التيار بعد تعرض الخلايا الشمسية الى النيوترونات يعود الى طبيعة تفاعل النيوترونات مع هذه النماذج والذي قد يؤدي الى : 1- زيادة نسبة التطعيم من خلال اضافة ذرات الالمنيوم



بالاضافة الى ذلك تفاعل النيوترون مع Si^{30} باحلال بيتا السالية وتحول الى (P^{31}) وهو يمثل واهب (Donor) [13] .



2- عند سقوط النيوترونات السريعة على المادة فان جزءا من طاقتها الحرارية سوف تتحول الى نسواة ذرة الهدف . بذلك فان الالكترونات في المدارات البعيدة عن النواة (الاغلفة الخارجية) والتي تكون طاقة ارتباطها قليلة بالنواة سوف تكتسب طاقة تمكنها من الانفصال عنها مما يحدث زيادة في التيار [14] .

3- يخلق التشعيع النيوتروني عيوب في طبقتي n و p حيث يعمل على ازاحة الذرات من مواقعها البلورية الى السطوح مؤدية بذلك الى خلق ما يسمى بعيوب شوتكي . كما يمكن ان تكون الازاحة في الشبكة الى موقع ببنية ما يخلق ازاحة ببنية فراغ وهذا ما يسمى بعيوب فرنكل . ان هذه الذرات المزاحاة عن مواقعها تسمى بالذرات الاولوية (Primary atoms) والتي بامكانها عند امتلاك الطاقة الكافية ازاحة ذرات ثانية اخرى مما يقود الى ظهور فجوات اخرى . ان ظهور هذه العيوب يؤدي الى انتاج مستويات موضعية (Localized energy levels) داخل فجوة الطاقة المحرمة للمادة مما يسبب انخفاضها مع توسيع طبقة الاستنزاف ومن ثم زيادة في تيار الدائرة القصيرة I_{SC} مما يقلل من مقاومة التوالى ثم حصول الزيادة في الكفاءة [15,13] . اما الزيادة في فولتية الدائرة المفتوحة فترتبط بانخفاض تيار الاشباع I_0 بالاعتماد على المعادلة التالية :

- وزارة التعليم الاشعاعات المؤينة.مطبعة العالي ، هيئة المعاهد الفنية .
- 7- Langman Dictionary of scientific usage Agodmen /EMF payne Langman Group Ltd,Essex 1979 .
- 8- Kaplon ,J . 1969, Neutron physics , Addison wesely Inc . Combridg e .
- 9- Dienes G. J , 1969, Studies in radiation effects in solids, 3:128-129 , P.Grodon & Breac, New York , London .
- 10- Tsoul Fanids, F. N, 1983 , Meaurement and Detection of radiation, London, Mc Graw-Hill .
- Hass L.D. 1980, solar Lett , radiation topical overview , Appl . 11- 36:320-2 . phys .
- 12- Wieder, Sol.1982, An Introduction to solar Energy for scientists and Englineers JohnWiley & Sons .
- 13- الراوي، صبحي سعيد . الجبورى، شاكر. حمدى، خالد ، العدد (2) 2001 . مجلة كلية التربية للبنات- جامعة بغداد. دراسة تأثير النيوترونات السريعة واسعة كاما على بعض نباتات اشيه الموصلات.
- 14- حسون، صلاح عبد الله . كاظم، نضالة حسن ياسين . سمير خضر العدد (3) 2000 . مجلة كلية التربية للبنات- جامعة بغداد . دراسة تأثير اشعة كاما والنيوترونات على كفاءة الخلية الشمسية الاحادية البليورة
- 15.Yamauchi,M.,Aurangzeb.K&Step hen.J.T.Koshi.A&Tsutomu.Ya. 1999,Deep level analysis of radiation-induced defects in si crystals and solar cells , Jornal of Applied physics ,86 :217-223.
- 16- Mukhopadhyay,K. & Saha,H. ,1981.Effect of Annealing Cds on Asintered Cds/Cu₂ solar cell. Solar Cell, 4 :135-146 .
- 17 - ز. اس. ام. ١٩٩٠، نبات اشيه الموصلات فيزياء وتقنيه.
- منطقة الاستزاف (عند مستويات التيار الواطنة) n عندما يكون التياران متقابلان في القيمة فان n يقع بين 1 و 2 (المستويات المتوسطة) [17] . وبذلك يمكن ان نستنتج من خلال ملاحظة قيم n المستخرجة لكل من التشعيع والتلدين لجميع الخلايا المستخدمة في هذا البحث ، ان ميكانيكية التيار لهذه الخلايا ناتجة عن اعادة الاتحاد في منطقة الاستزاف .
- ان الانخفاض في قيمة I_0 لخلية S3 بعد تشعيتها بالنيوترونات ناشئ عن العيوب المترتبة والمذكورة مسبقاً مما ادى الى زيادة في كل من المستويات الموضعية و زمن بقاء الحاملات مع انخفاض الجهد الحاجز وهذا قاد الى انخفاض في قيمة n اي انخفاض تيار الاتحاد في منطقة الاستزاف .
- كما وجد ان تلدين خلية Sc ادى الى انخفاض قيمتي I_0 و n وهذا يعود الى ان التلدين في الفراغ سبب طرد الاوكسجين من المادة مما قاد الى انخفاض الجهد الحاجز مع انخفاض معدل اعادة الاتحاد .
- وهذا يفسر الانخفاض في قيمتي I_0 و n لخلية S3 المشععة بعد تلديتها حراريا . بالرغم من ذلك عند مقارنة التغير البسيط في قيم n المقاسة قبل وبعد كل من التشعيع والتلدين للخلايا نلاحظ ثبوت ميكانيكية التيار وبقاءها ناشئة عن اعادة الاتحاد في منطقة الاستزاف.
- المصادر:**
- 1- Carlson D.E. , Wronski C.R.,1979, Isotopes in applied physics' , Amorphous semiconductor, ed. By M.H. Borsky, 36:287-329.
- Fahrenbruch, A.L. and Bube P.H.1973.
- 2- conf . Rec . IEEE photo,spec conf.10th .
- 3- الغني، د.سامي عبد ، حسون. صلاح عبد الله ، ياسين. سمير خضر، العدد ١٩٩٩ . ٤ / . مجلة كلية التربية / الجامعة المستنصرية، دراسة تطوير خلية شمسية سليكونية احادية البليورة .
- 4- والنعمه، محمد وكاع فرحان . انور، مظفر 2001. ، فيزياء الالكترونات.
- 5- العارف، د. معن صفاء ، ١٩٩٩، الفيزياء الحياتية الاشعاعية ، ط١،الأردن .
- 6- الكناوي، عذاب طاهر نعميش. الخفاجي ، اسعد محمد جعفر، 1990. الكشف عن

- 19.Bakirov,.M.ya.Madatov.R.S,Mushta
faev.Yu.M,gasimov.R.R&Godzhaev.F
B, 1988. radiation Effect in
silicon high-voltage photovoltaic cells
Exposed to electrons with Energy of
5Mev . Geliot ekhnika, 24(5): 76-77 .
- 18- Bandyopadhyay T.K. & chaudhuri
.S.R,1985.Influence of Annealing
Ambients on thin film Cdte for solar
energy conrersion , phys. Stat. Sol .
5: 92,637

An Imperovement of the efficiency of Solar Cell using neutron Irradiation and Thermal Annealing

*Al-Ta'ay . W.A.

**Al- Qaraguly. R.

***Al-Rawi . S.S.

* Al-Nahrain Univ/ College of Sciense/ Dept. of Physics.

** Baghdad Univ/ College of Sciense for Women/ Dept. of Physics.

*** Tikrit Univ/ College of Sciense/ Dept. of Physics.

Abstract

The aim of this work is to study the effects of the neutrons of energy (4-8 Mev) and also the thermal annealing on the efficiency of a singl crystal silicon solar cell .

Electrical characteristics curves (I-V) are studied for these cells in the dark and illumination befor and after irradiation using the neutron source ($^{241}\text{Am-Be}$) as well as those before and after annealing .

High efficiency was observed after irradiation (3.81%) and after annealing was (0.72%) .